

بررسی عملکرد کوره القایی ذوب براساس طراحی بهینه خازن در مدار اینورتر رزونانس موازی

رحمت‌الله هوشمند^{۱*}، آرش کیومرثی^۲، مریم محبی‌زاده^۳

۱- دانشیار مهندسی برق، دانشگاه اصفهان

۲- استادیار مهندسی برق، دانشگاه اصفهان

۳- کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه اصفهان

*اصفهان، کد پستی ۸۱۷۴۶-۷۳۴۴۱

Hooshmand_r@eng.ui.ac.ir

(دریافت مقاله: فروردین ۱۳۸۶، پذیرش مقاله: اردیبهشت ۱۳۸۷)

چکیده - کوره القایی یکی از ابزارهای گرمایش بدون تماس مواد است. در این کوره‌ها از جریان با فرکانس بالا برای گرم کردن مواد هادی الکتریکی استفاده می‌شود. از آنجا که این روش بدون تماس است، لذا باعث آسودگی یا ایجاد ناخالصی در بار نمی‌شود. در طراحی سیستم اینورتر رزونانس موازی برای تغذیه کوره‌های القایی، انتخاب مناسب خازن برای مدار رزونانس بسیار مهم است. انتخاب این خازن بر فرکانس رزونانس، توان خروجی، ضربی قدرت، ضربی کیفیت و کارایی کوره اثر دارد. در این مقاله علاوه بر مدل‌سازی دقیق اینورتر و یکسوساز، روش مناسبی برای انتخاب مقدار بهینه خازن ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم محدودیت ولتاژ اجباری موجود، بیشینه توان خروجی کوره و حداقل توان تلف شده در خازن حاصل شود. همچنین نقش مقاومت معادل سری خازن در انتخاب خازن بررسی می‌شود. در نهایت برای اجرای الگوریتم پیشنهادی، با تعیین خازن بهینه برای کوره ذوب، مدل کامل کوره و سیستم تغذیه آن شبیه‌سازی و اثر مقدار خازن پیشنهادی ارزیابی می‌شود.

کلید واژگان: کوره القایی ذوب، اینورتر رزونانسی، مدل‌سازی، طراحی بهینه خازن رزونانس.

دیگر، برای کارکرد بهینه کوره باید ظرفیت بانک خازنی به کمک بهینه‌سازی تعیین شود [۱، ۲، ۳، ۹-۱۰، ۱۵-۱۶، ۱۸-۱۹]. در بعضی موارد، با توجه به عمق نفوذ دلخواه، فرکانس ثابتی انتخاب شده و مقدار خازن تعیین می‌شود [۱، ۵]. البته در کوره‌های ذوب یا کوره‌های با هدف گرم کردن قطعات عبورکننده، انتخاب خازن را می‌توان بر اساس توان رسیده به بار و توان تلف شده در خازن انجام داد [۹، ۵]. از طرف دیگر لازم است مدل دقیقی از سیستم تغذیه کوره تهیه شود تا طراحی بانک خازنی با دقت کافی همراه باشد.

۱- مقدمه

کوره‌های القایی به سبب کارایی گرمایی خوب، سرعت تولید زیاد، محیط کار تمیز و آسوده نکردن قطعه کار در صنایع فلزی برای ذوب و گرم کردن (به‌منظور شکلدهی فلزها) به‌طور گسترده‌ای به کار می‌روند. در زمینه مدل‌سازی کوره‌های القایی تحقیقات زیادی انجام شده است [۱]-[۱۹]. یکی از مسائل مهم در این کوره‌ها تعیین مدل دقیقی برای کویل و بار کوره است. هر کوره بسته به نوع تغذیه و کاربرد آن، به روش خاصی مدل‌سازی می‌شود. از طرف

در کوره القایی با توجه به توان آن، ظرفیت بانک خازنی انتخاب می‌شود. در اینورتر رزونانس موازی، اگر فرکانس سویچینگ نزدیک به فرکانس رزونانس باشد، ولتاژ خروجی اینورتر (ولتاژ دو سرخازن) بیشترین مقدار خود را خواهد داشت. در این حالت، ضریب قدرت (PF) ^۲ نزدیک به ۱ بوده و توان بیشتری نیز تولید می‌شود [۸، ۱۰]. البته باید در نظر داشت که ولتاژ دو سرخازن (V_C) باید از ولتاژ نامی بانک خازنی V_{max} همواره کوچکتر باشد. این حاشیه ولتاژ همیشه باید حفظ شود؛ زیرا کار کردن در حداقل ولتاژ برای خازن، باعث افزایش تلفات در خازن و کاهش عمر آن می‌شود. یکی از عواملی که به طور مستقیم در تولید دامنه ولتاژ خازن V_C تأثیر دارد، زاویه آتش یکسوکننده است که مقدار I_{dc} را تعیین می‌کند که آن هم ولتاژ خازن و توان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی دیگر از عوامل تولید توان کوره، فرکانس رزونانس است که به ظرفیت خازن بستگی دارد. ظرفیت بانک خازنی، همه عوامل کوره القایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این عوامل از قبیل فرکانس رزونانس، ضریب کیفیت، راندمان و ضریب قدرت است. بنابر این در این مقاله، روشی برای انتخاب ظرفیت بهینه خازن (C_{opt}) ارائه می‌شود که حداقل توان خروجی و در همان حال کمترین تلفات خازن را ایجاد کند.

بدین منظور یک مدل کوره القایی و تغذیه آن ارائه می‌شود که در آن، به جای کویل و بار کوره، از اندوکتانس و مقاومت سری استفاده می‌شود و به جای بانک خازنی از خازن خالص با مقاومت معادل سری استفاده می‌شود. به کار بردن این مدل، باعث می‌شود که توان خروجی کوره و تلفات توان در خازن را بتوان به عنوان تابعی از ظرفیت خازن بیان کرد. بنابر این یک مقدار بهینه خازن تحت ولتاژ اجباری با ضرایب معادلات لاغرانژ محاسبه می‌شود.

البته در بیشتر مراجع، از مدل تونن منبع تغذیه استفاده شده که این تقریب در مدل‌سازی، باعث کاهش دقت بررسی عملکرد کوره و طراحی در بانک خازنی می‌شود [۱، ۱۵، ۱۲-۷]. در این مقاله، اولاً یک مدار معادل کوره القایی و بار آن برای کوره ذوب ارائه می‌شود. در این مدل، به جای کویل کوره و بار آن، از اندوکتانس معادل همراه با مقاومت سری استفاده شده و به جای بانک خازنی از خازن ایدئال با مقاومت معادل سری استفاده می‌شود. ثانیاً به منظور افزایش دقت در طراحی خازن بهینه، از مدار معادل کامل سیستم تغذیه (شامل سیستم اینورتر و یکسوساز) نیز در شبیه‌سازی استفاده شده است.

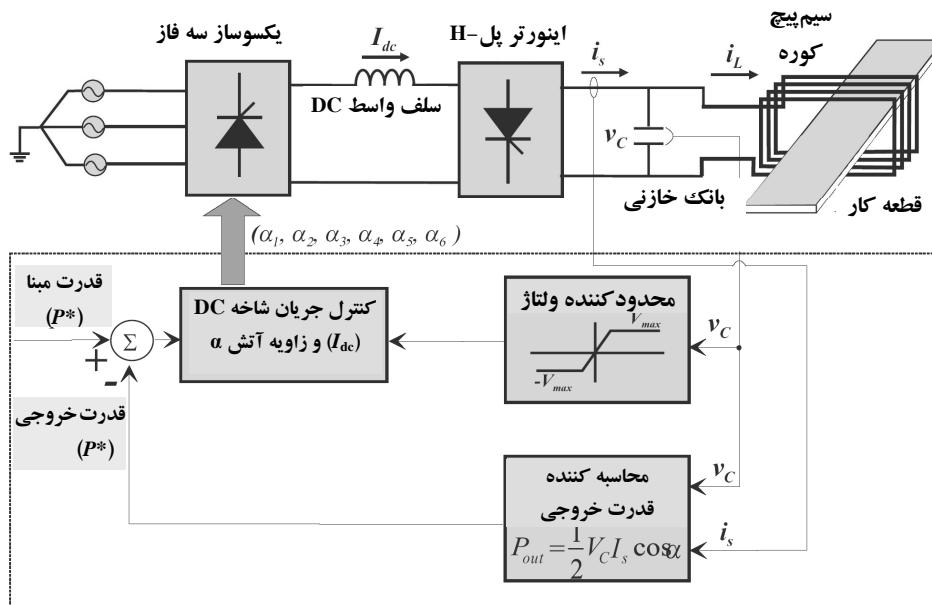
در این مقاله، کوره ذوب با توان 250 kW مد نظر است که در کارخانه ریخته‌گری مذاب‌ساز واقع در شهرک صنعتی اشترجان قرار دارد و در حال حاضر مشکل جذب توان در دمای بالاتر از 1200°C دارد. نتایج شبیه‌سازی، شرایط لازم برای کارکرد بهینه کوره را مشخص می‌سازد.

۲- سیستم کوره القایی

بلوک دیاگرام کوره القایی رزونانس موازی نوعی در شکل ۱ نشان داده شده است. در این مدل، یکسوکننده کترول شده فاز همراه با سلف واسطه، یک منبع جریان dc ثابت را ایجاد می‌کند. پل اینورتر شامل چهار تریستور و یک مدار رزونانس موازی متشکل از بانک خازنی و کویل کوره است. تریستورها بهوسیله جریان متناوب مدار رزونانس کموتاسیون می‌کنند و لذا به آنها اینورتر کموتاسیون بار می‌گویند [۱۹-۱۷، ۹-۵، ۲-۱].

خازن همراه با اندوکتانس کویل، یک بار نوسانگر برای اینورتر ایجاد می‌کند که البته در فرکانس رزونانس، وظیفه جبران اندوکتانس کویل را هم بر عهده دارد. بلوک‌های کترولی شامل آشکارسازهای ولتاژ و جریان، مدار تنظیم شونده^۱، مدار کترول خروجی و مدارهای تولید پالس گیت است [۴، ۱۱، ۱۲، ۱۵-۱۷].

1. Tuned Circuit



شکل ۱ بلوک دیاگرام کوره القایی

$$R_C = K \left(\frac{K_r \cdot \pi \cdot \delta_C}{2} \right) \quad (3)$$

۴- راکتانس فاصله هوایی بر حسب اهم:

$$X_g = K(A_g) \quad (4)$$

۵- راکتانس قطعه کار بر حسب اهم:

$$X_W = K(\mu_r \cdot q \cdot A_W) \quad (5)$$

۶- راکتانس کویل بر حسب اهم:

$$X_C = K \left(\frac{K_r \cdot \pi \cdot d_C \cdot \delta_C}{2} \right) \quad (6)$$

لازم است ذکر شود که ثابت K بر حسب اهم بر متر مربع به شکل زیر تعیین می شود:

$$K = \frac{2\pi \cdot f \cdot \mu_0 \cdot N_C^2}{l_C} \quad (7)$$

در این روابط A_w , A_g , N_C , d_C , μ_r , δ_C و ρ به ترتیب سطح مقطع قطعه کار (متر مربع)، سطح مقطع فاصله هوایی (متر

۳- تحلیل سیستم

۱-۳-۱- مدار معادل

از آنجاکه تشابه زیادی بین کوره القایی و ترانسفورماتور وجود دارد، لذا مناسب است که برای به دست آوردن مقادیر مقاومت‌ها و راکتانس‌ها، مدار معادل پسیو کویل و بار آن را به صورت R_{eq} و L_{eq} به صورت سری در نظر گرفت. برای رسیدن به این هدف، از شدت میدان مغناطیسی لازم برای تولید گرما در سطح قطعه کار و محاسبه شارهای دور زننده در قطعه کار، در فاصله هوایی و در سطح کویل استفاده شده است.

پارامترهای این مدار معادل به صورت زیر بیان می‌شود:

۱- امپدانس کل بر حسب اهم:

$$Z = (R_W + R_C) + j(X_g + X_W + X_C) \quad (1)$$

۲- مقاومت اهمی قطعه کار بر حسب اهم:

$$R_W = K(\mu_r \cdot p \cdot A_W) \quad (2)$$

۳- مقاومت اهمی کویل بر حسب اهم:

که در آن:

$$\begin{aligned} Z_{\text{ESR}} &= R_{\text{ESR}} = \frac{K}{C}, \quad Z_R = R_{\text{eq}}, \\ Z_C &= \frac{1}{j\omega_s \cdot C}, \quad Z_L = j\omega_s \cdot L_{\text{eq}} \end{aligned} \quad (10)$$

یکسونده و اینورتر پل کوره القایی بهوسیله جریان مربعی شکل منبع (I_{dc}) توصیف می‌شوند. سری فوریه این جریان منبع چنین است:

$$i_s(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4I_{\text{dc}}}{n\pi} \sin(n\omega_s t) \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

لذا مؤلفه اصلی موج مربعی منبع جریان برطبق رابطه زیر بهدست می‌آید:

$$i_s(t) = \frac{4}{\pi} I_{\text{dc}} \sin \omega_s t = I_s \sin \omega_s t \quad (11)$$

که در آن $I_s = \frac{4}{\pi} I_{\text{dc}}$ ، پیک جریان i_s است. جریانی که از R_{ESR} و R_{eq} می‌گذرد، به ترتیب با i_L و i_C نشان می‌دهیم که بیان فازوری این دو جریان چنین است:

$$I_L = \frac{V_C}{Z_L + Z_R} = \frac{Z_C + Z_{\text{ESR}}}{Z_L + Z_R + Z_C + Z_{\text{ESR}}} \cdot I_s \quad (12)$$

$$I_C = \frac{V_C}{Z_C + Z_{\text{ESR}}} = \frac{Z_L + Z_R}{Z_C + Z_{\text{ESR}} + Z_L + Z_R} I_s \quad (13)$$

در این رابطه، V_C و I_S فازروهای v_C و i_S است و $V_C = Z_t \cdot I_s$. بنابراین توان خروجی کوره P_{out} و تلفات توان خازن P_{loss} برابر است با:

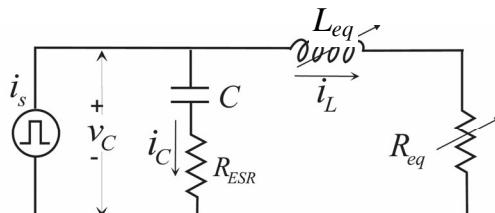
$$\begin{aligned} P_{\text{out}}(C) &= \left(\frac{I_L}{\sqrt{2}} \right)^2 Z_{\text{eq}} = \frac{1}{2} \left| \frac{Z_C + Z_{\text{ESR}}}{Z_L + Z_R + Z_C + Z_{\text{ESR}}} \right|^2 I_s^2 \cdot Z_{\text{eq}} \\ &= \frac{\pi^2 I_{\text{dc}}^2}{\pi^2} \left| \frac{\omega_s K - j}{\omega_s C \cdot (R_{\text{eq}} + \frac{K}{C}) + j(\omega_s \cdot C \cdot L_{\text{eq}} - 1)} \right|^2 R_{\text{eq}} \end{aligned} \quad (14)$$

مربع)، عمق نفوذ جریان در کویل (متر)، تعداد دور کویل، ارتفاع کویل (متر)، قطر داخلی کویل (متر)، ضریب تصحیح کویل و مقاومت ویژه قطعه کار (اهم بر متر) است. ضریب μ قابلیت گذرهای نسبی مغناطیسی قطعه کار بوده و p و q نیز مقادیر عددی است که بر اساس عمق نفوذ (d/δ) بهدست می‌آیند. با استفاده از شکل ۱ مدار معادل ساده شده برای کوره القایی و تغذیه آن در شکل ۲ نشان داده شده که پارامترهای L_{eq} و R_{eq} اندوکتانس معادل و مقاومت معادل کویل و بار کوره است که بر طبق روابط (۱) تا (۷) بهدست می‌آید [۱۸]. لازم است ذکر شود که با توجه به آنکه L_{eq} و R_{eq} به شرایط بار کوره، خاک کوره و شرایط محیطی بستگی دارد، لذا در شکل مذکور، این پارامترها به صورت متغیر نشان داده شده است.

برای توصیف تلفات توان در بانک خازنی، R_{ESR} مقاومت معادل سری با خازن در نظر می‌گیریم که مقادار R_{ESR} از رابطه زیر بهدست می‌آید:

$$R_{\text{ESR}} = \frac{K}{C} \quad (8)$$

که K بر طبق استاندارد IEC-۶۰۲۵۲ در حدود $1.2 \times 10^{-6} \Omega \cdot F$ تا $1.5 \times 10^{-6} \Omega \cdot F$ در نظر گرفته می‌شود.



شکل ۲ مدار معادل ساده شده کوره و تغذیه آن

۲-۳- معادلات توان

یک متغیر مفید برای محاسبه توان، امپدانس نهایی دیده شده از مدار معادل منبع در شکل ۲ است که از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\begin{aligned} Z_t &= \frac{(Z_C + Z_{\text{ESR}}) \cdot (Z_L + Z_R)}{Z_C + Z_{\text{ESR}} + Z_L + Z_R} = \\ &\frac{(\omega_s \cdot k \cdot R_{\text{eq}} + \omega_s \cdot L_{\text{eq}}) + j(\omega_s \cdot L_{\text{eq}} \cdot k - R_{\text{eq}})}{\omega_s (C \cdot R_{\text{eq}} + k) + j(\omega_s \cdot L_{\text{eq}} \cdot C - 1)} \end{aligned} \quad (9)$$

برای خازن است که حداکثر توان خروجی و حداقل تلفات در خازن را تحت ولتاژ اجباری (بیان شده در رابطه (۱۶)) ایجاد کند. اگر تابع هدف در طراحی برابر با $P_{\text{out}} - P_{\text{loss}}$ انتخاب شود، آنگاه بیشینه این تابع بهمازای حداکثر شدن P_{out} و حداقل شدن P_{loss} است. بنابر این حداکثر $P_{\text{out}} - P_{\text{loss}}$ با در نظر گرفتن معیار $|Z_t(j\omega_0)| \times (\frac{\pi}{4} I_{\text{dc}}) \leq V_{\text{max}}$ مورد نظر است. بدین منظور ابتدا تابع ارزش $J(C)$ به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۰]:

$$J(C) = P_{\text{out}} - P_{\text{loss}} + \lambda(V_{\text{max}} - |Z_t(j\omega_0)| \cdot \frac{\pi}{4} I_{\text{dc}})$$

که در این رابطه، $\lambda \geq 0$ ضریب لاغرانژ است. برای تعیین مقدار بیشینه $J(C)$ باید $\frac{\partial J}{\partial C} = 0$ شود؛ لذا:

$$\frac{\partial J}{\partial C} = 0 \Rightarrow \lambda(V_{\text{max}} - |Z_t(j\omega_0)| \cdot \frac{\pi}{4} I_{\text{dc}}) = 0 \quad (17)$$

با حل این معادله، مقدار بهینه خازن C_{opt} به دست می‌آید.

۵- نتایج شبیه‌سازی

در این بخش، ابتدا به ارائه مدل کامل تغذیه کوره می‌پردازیم. سپس با ارائه نتایج شبیه‌سازی مدل، نتایج به دست آمده تحلیل و ارزیابی می‌شود.

۱-۱- مدل شبیه‌سازی

در راستای مدل‌سازی سیستم و طراحی بهینه بانک خازنی از کوره ذوب نمونه‌ای استفاده می‌شود که ابعاد آن به شرح ذیل است:

: تعداد دور کویل	$N_C = 25 \text{ turns}$
: طول (ارتفاع) کویل	$l_C = 40 \text{ cm}$
: قطر قطعه کار	$d_w = 34 \text{ cm}$
: قطر داخلی کویل	$a_c = 44 \text{ cm}$
: فرکانس کار	$f = 1250 \text{ Hz}$
: ضریب تصحیح	$k_r = 1/5$

$$P_{\text{loss}}(C) = \left(\frac{I_C}{\sqrt{r}} \right)^2 Z_{\text{ESR}} = \frac{1}{r} \left| \frac{Z_L + Z_R}{Z_L + Z_R + Z_C + Z_{\text{ESR}}} \right|^2 I_s^2 \cdot Z_{\text{ESR}} \quad (15)$$

$$= \frac{\pi I_{\text{dc}}^2}{\pi^2} \left| \frac{\omega_s C \cdot (R_{\text{eq}} + j\omega_s L_{\text{eq}})}{\omega_s C \cdot (R_{\text{eq}} + \frac{K}{C}) + j(\omega_s^2 \cdot C \cdot L_{\text{eq}} - 1)} \right|^2 \frac{K}{C}$$

این رابطه نشان می‌دهد که P_{out} و P_{loss} توابعی از خازن C هستند؛ زیرا همه پارامترها به جز خازن در معادلات (۱۴) و (۱۵) معلوم هستند. لازم است ذکر شود که فرکانس سویچ زنی اینورتر (ω_s) باید از فرکانس رزونانس LC بار، بیشتر باشد تا کموتاسیون تریستورها تضمین شود و اندوکتانس دیده شده از اینورتر، خازنی باشد. این موضوع، شرط لازم برای تطبیق امپدانسی بین اینورتر و یکسوساز است. لذا با توجه به پیش‌فازی جریان در خازن (نسبت به ولتاژ آن)، لحظه سویچ زنی باید قبل از صفر شدن ولتاژ دو سر کویل باشد. به این منظور مناسب است $\omega_s = 1/\omega_0$ در نظر گرفته شود که $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ است [۱۸، ۱۵، ۱] .

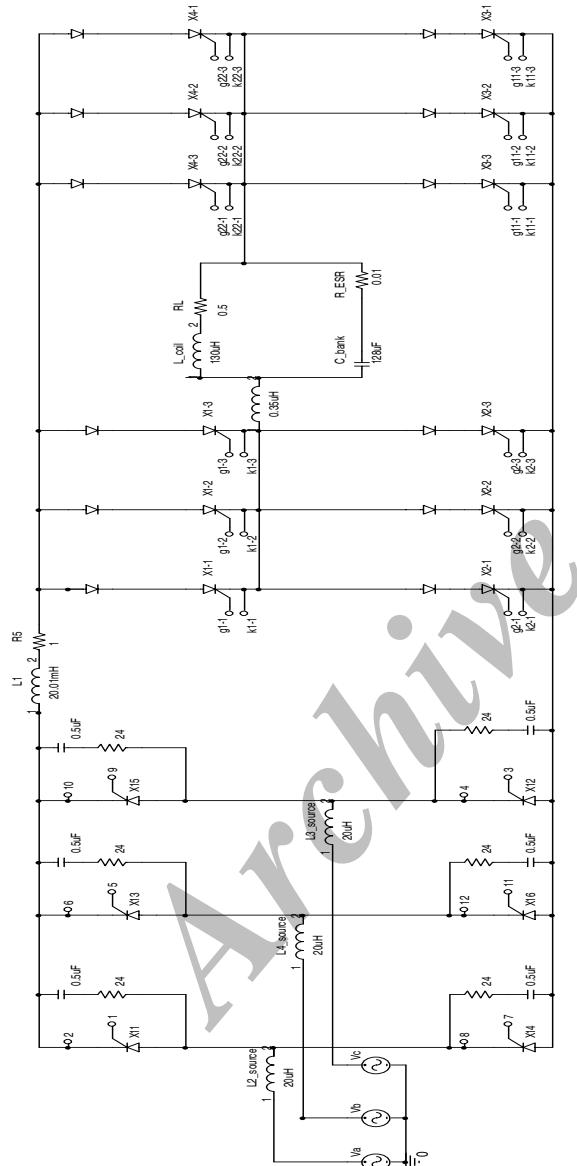
۴- تعیین ظرفیت خازن بهینه برای بیشینه توان خروجی و کمینه تلفات توان در خازن

برای داشتن حداکثر توان خروجی، لازم است ولتاژ دو سر کویل در حالت حداکثر باشد. این نکته به معنای ایجاد ولتاژی بزرگ در دو سر خازن است. از طرفی یک ولتاژ اجباری روی خازن وجود دارد که ناشی از محدودیت ولتاژ نامی بانک خازنی است. بر این اساس، مقدار این ولتاژ بر اساس مدار معادل شکل ۲ برابر است با:

$$V_C = |Z_t(j\omega_s)| \cdot I_s = |Z_t| \cdot \frac{\pi}{4} I_{\text{dc}} \leq V_{\text{max}} \quad (16)$$

در این رابطه، V_{max} ولتاژ نامی بانک خازنی و Z_t امپدانس نهایی دیده شده از منبع است. همچنین مقدار $|Z_t(j\omega_s)| = |Z_t(j\omega_0)|$ نیز به ظرفیت بانک خازنی (C) بستگی دارد. در اینجا هدف، به دست آوردن مقدار بهینه‌ای

۵۰Hz است که به یکسوساز سه فاز تمام کترل شونده اعمال می‌شود. سیشن تریستور X₁₁ تا X₁₆ یکسوساز را تشکیل می‌دهند. مقاومت‌های سری با خازنها در دو سر تریستورها نقش اسناپر را ایفا می‌کنند. خروجی یکسوساز، ولتاژی dc است که توسط سلف واسطه L₁ به جریان dc ثابت تبدیل می‌شود. این جریان ثابت dc، تغذیه اینورتر را تشکیل می‌دهد.



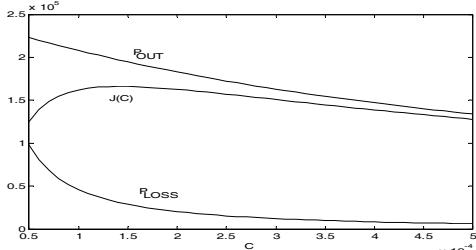
شکل ۴ مدار کامل کوره و منبع تغذیه آن (یکسوساز، سلف بزرگ واسطه، اینورتر و مدل کوره)

با توجه به اینکه در این کوره، افزایش دما از ۱۰۰۰°C در ۱۳۰۰°C، بیشترین مصرف توان را دارد، لذا فقط به بررسی در این محدوده دمایی (بعد از نقطه کوری) می‌پردازیم. با این کوره از جنس فولاد است. لذا داریم:

$$\rho_w = 117 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$$

$$\mu_w = 1$$

بنابراین کوره مورد نظر با R_{eq} سری با برابر 0.5Ω و L_{eq} $130\mu H$ مدل‌سازی می‌شود. پارامترهای کوره: $V_{max} = 170V$ ، $R_{eq} = 0.53\Omega$ ، $L_{eq} = 130\mu H$ و $K = 1.33 \times 10^{-9} \Omega \cdot F$ در نظر گرفته می‌شود. شکل ۳ نمودارهای P_{out} ، $J(C)$ و P_{loss} (تابع ارزش) را بر حسب تغییرات ظرفیت بانک خازنی (C) نشان می‌دهد. همان‌گونه که از این شکل مشخص می‌شود، ظرفیت بانک خازنی $C_{Bank} = 128\mu F$ ، انتخاب بهینه است. البته با این انتخاب بهینه، حداقل توان خروجی مهیا نمی‌شود اما میزان کاهش تلفات بانک خازنی به حدی است که بازده کل سیستم را بهبود می‌بخشد. از طرف دیگر، کاهش توان تلفاتی در خازن، سبب تقلیل افزایش دمای کارکرد خازن شده و در نتیجه، عمر خازن افزایش می‌یابد. از طرفی، ملاحظه کردن حاشیه ولتاژ کارکرد خازن و ولتاژ نامی آن، باعث افزایش عمر بانک خازنی می‌شود.



شکل ۳ نمودارهای توان خروجی (P_{out})، توان تلفاتی (P_{loss}) در خازن و تابع ارزش ($J(C)$) بر حسب تغییرات خازن

شکل ۴ مدار کامل تغذیه کوره مورد نظر را نشان می‌دهد. این مدار شامل ورودی سه فاز ۱۰۰V با اتصال ستاره با فرکانس

ج) در نظر گرفتن زمان دلخواه برای ایجاد جریان تقریباً ثابت برای تغذیه اینورتر [۱۹، ۱۸]. اگر چه شروع به کار اینورتر و رسیدن به حالت دائم و پایدار برای جریان سلف، توسط مدارهای استارت انجام می‌شود اما مقدار این سلف، تعیین کننده مدت زمان گذرا مدار است. هر چه این سلف، مقدار بزرگتری داشته باشد، زمان لازم برای رسیدن جریان تغذیه کننده اینورتر به مقدار نهایی خود، طولانی‌تر می‌شود. این سبب طولانی شدن زمان گذرا می‌شود [۱۵، ۱۶].

۲-۵-بررسی و تحلیل نتایج شبیه‌سازی

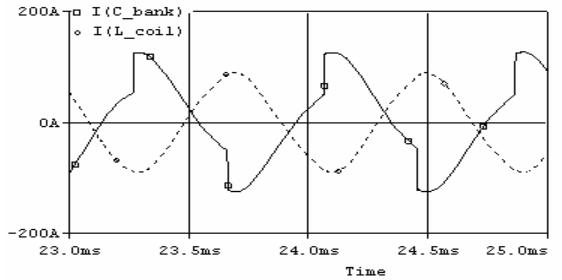
شکل ۵ نتایج شبیه‌سازی عملکرد این کوره را نشان می‌دهد. شکل ۵ تحلیل مدار در مدت 25msec و رسیدن به حالت پایدار را نشان می‌دهد. شکل ۵-الف جریان گذرنده از سلف واسطه و ولتاژ دو سر بانک خازنی را نمایش می‌دهد. شکل ۵-ب جریان بانک خازنی و جریان عبور کننده از کویل کوره را نشان می‌دهد. شکل ۵-ج ولتاژ دو سر کوره را همراه با ولتاژ ورودی اینورتر در مدت 25msec نشان می‌دهد. این ولتاژ از این نظر که در زمانهایی دارای مقدار منفی است، در حالی که جریان ورودی اینورتر مثبت است (یعنی اینورتر به شبکه توان بر می‌گردداند) حائز اهمیت است. شکل ۶ قسمت پایدار تحلیل را با بزرگنمایی بیشتر نشان می‌دهد تا شکل موج‌ها با دقت بالاتری قابل پیگیری باشند. شکل ۶-الف، جریان گذرنده از کویل و جریان بانک خازنی را نشان می‌دهد. در شکل ۶-ب ولتاژ دو سر بانک خازنی و ولتاژ ورودی اینورتر نشان داده شده است و شکل ۶-ج جریان و ولتاژ کوره را نشان می‌دهد. از آنجاکه در یکسوکننده و اینورتر، عمل کلیدزنی اتفاق می‌افتد، جریانی که از هر یک از فازهای منبع، کشیده می‌شود دارای هارمونیک‌های بزرگی است. با قرار دادن یک سلف در ورودی هر فاز و استفاده از مدارهای استنابر برای تریستورها می‌توان تا حدی شدت این هارمونیک‌ها را کاهش داد. شکل ۷-الف، جریان کشیده شده از فاز C و جریان گذرنده از

در مدار اینورتر از ۱۲ تریستور X_{۱-۱} تا X_{۱-۳} (شامل X_{۴-۱} تا X_{۴-۳}) استفاده شده است. هر نیم ساق این اینورتر شامل سه شاخه موازی است که هر شاخه از یک تریستور و یک دیود سری تشکیل شده است. برای عبور جریان زیاد از اینورتر، به تریستورهای جریان بالا نیاز داریم یا می‌توانیم تریستورهای مشابه با جریان کمتر را موازی کنیم. در این مدار از روش دوم برای افزایش توان جریان دهی استفاده شده است. از طرفی برای افزایش تحمل ولتاژ معکوس دو سر تریستورها و قدرت سدکنندگی ولتاژ مستقیم، از تریستورهای سری استفاده می‌شود. البته در این مدار از یک تریستور سری با یک دیود استفاده شده است. این ترکیب اگر چه تحمل ولتاژ معکوس را افزایش می‌دهد اما باعث افزایش قدرت سدکنندگی ولتاژ مستقیم نمی‌شود. ما در شبیه‌سازی از ترکیب تریستور سری با دیود استفاده می‌کنیم تا جریان توسط دیود قطع شود تا این باعث قطع شدن تریستور شود.

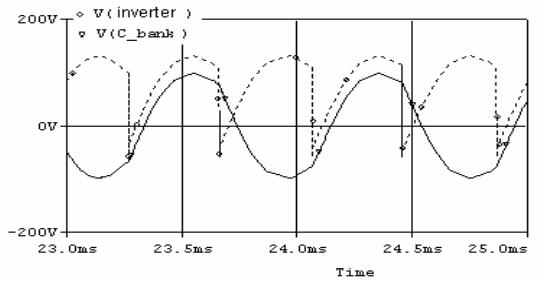
همچنین در این مدار، از مدار RL سری برای مدل‌سازی کوره و خازن سری با مقاومت برای مدل‌سازی بانک خازنی استفاده می‌شود که این مقادیر برابر $R_L = 0.5\Omega$ و $R_{ESR} = 130\mu\text{H}$ بوده و مقادیر R و C نیز برابر $R = 0.1\Omega$ و $C = 128\mu\text{F}$ در نظر گرفته شده‌اند.

لازم است ذکر شود که در شکل ۴، سلف واسطه، یک سلف بزرگ ($10-25\text{mH}$) است که برای جذب جهش‌های جریان به کار می‌رود. به عبارت دیگر این سلف مانند مبدل منبع ولتاژ ثابت به منبع جریان ثابت عمل می‌کند که جریان تقریباً ثابتی را برای اینورتر در طول کموتاسیون بار ایجاد می‌کند. معیار طراحی مقدار این سلف بر اساس سه پارامتر زیر طراحی می‌شود:

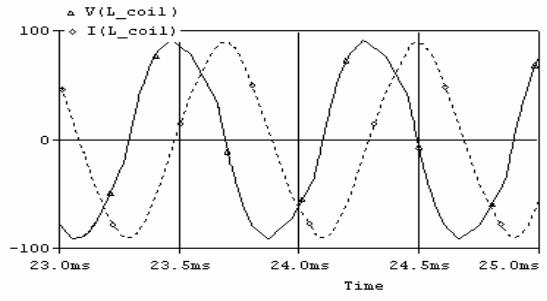
الف) حداکثر جریان قابل تحمل تریستورهای اینورتر در زمان اتصال کوتاه ساقهای اینورتر به علت کموتاسیون؛
ب) حداکثر تحمل di/dt تریستورهای اینورتر در زمان سویچ‌زنی اینورتر؛



(الف)



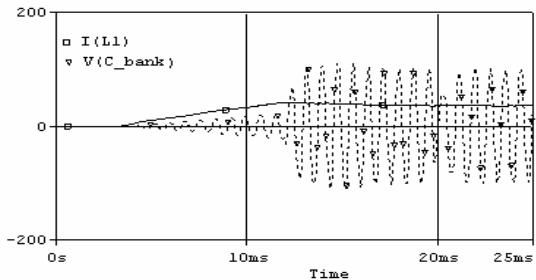
(ب)



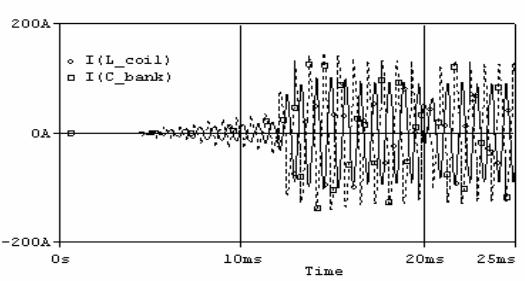
(ج)

شکل ۶ مشخصات کویل و بانک خازنی؛ (الف) جریان کویل و جریان بانک خازنی؛ (ب) ولتاژ بانک خازنی و ولتاژ ورودی اینورتر؛ (ج) جریان کویل و ولتاژ آن

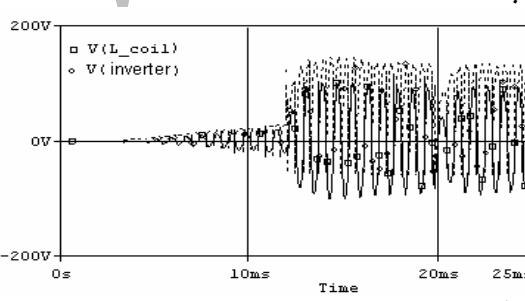
شکل ۸ توان خروجی کوره و توان تلفاتی در خازن را برای کوره مشخص شده در شکل ۴ برای دو ظرفیت بهینه و فعلی خازن نشان می‌دهد. شکل ۸-الف، تغییرات P_{out} و P_{loss} را با خازن بهینه $C_{Bank}=C_{opt}=128\mu F$ مشخص می‌کند و شکل ۸-ب نیز همین نمودارها را برای حالت فعلی کوره با خازن $C_{Bank}=150\mu F$ نشان می‌دهد.



(الف)



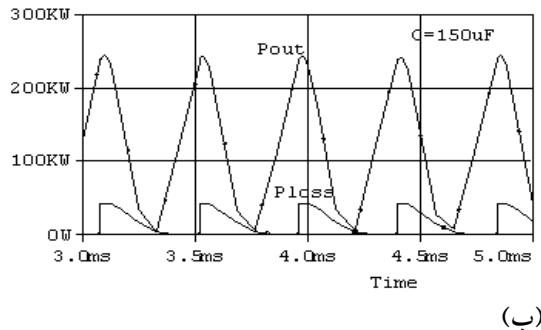
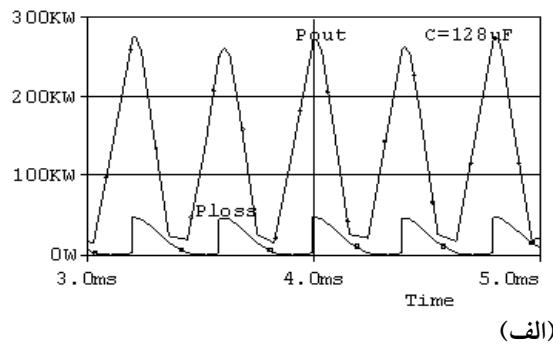
(ب)



(ج)

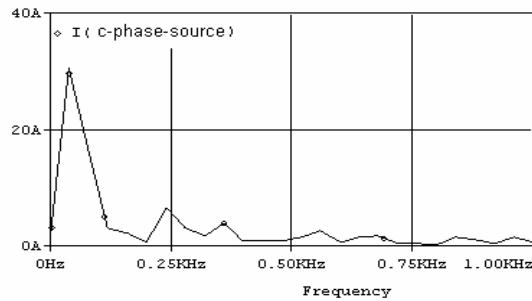
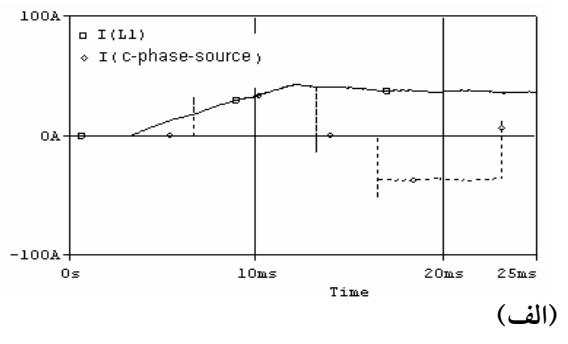
شکل ۵ تحلیل مدار تا زمان ۲۵msec برای مشاهده رسیدن به پایداری؛ (الف) ولتاژ خازن و جریان سلف واسط؛ (ب) جریان‌های کویل کوره و بانک خازنی؛ (ج) ولتاژ‌های دو سر کویل و ورودی اینورتر

سلف واسط را نشان می‌دهد. جریان فاز C در حوزه فرکانس در شکل ۷-ب نشان داده شده است. مطابق آنچه انتظار داشتیم در فرکانس ۵۰Hz، مؤلفه اصلی، بیشترین دامنه را دارد و هارمونیک‌های پنجم و هفتم (فرکانس‌های ۲۵۰Hz و ۳۵۰Hz) نیز در این جریان، بزرگ و قابل توجه است. مجموع دامنه این دو هارمونیک، تقریباً یک چهارم مؤلفه اصلی است که سبب ایجاد اعوجاج هارمونیکی کل به مقدار ۲۷٪ می‌شود.



شکل ۸ توان خروجی و توان تلف شده در خازن برای
الف) $C=128\mu F$; ب) $C=150\mu F$

شکل ۹ توان خروجی P_{out} توان تلف شده در خازن وتابع ارزش $J(C)$ را بر حسب R_{eq} و C نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۹-الف- که نمودار P_{out} است - در کمترین مقدار C بیشترین P_{out} داریم؛ زیرا مقدار کوچک خازن باعث افزایش فرکانس رزونانس و فرکانس سویچینگ می‌شود و در نتیجه توان رسیده به بار افزایش می‌یابد؛ لذا افزایش ظرفیت خازن باعث کاهش فرکانس و در نتیجه کاهش P_{out} می‌شود. اکنون اگر ظرفیت بانک خازنی ثابت باشد، وقتی امپدانس بار (R_{eq}) برابر با کل امپدانس دیده شده از دو سر بار (R_t) باشد (یا به بیان دیگر امپدانس بار با امپدانس دیده شده از دو سر بار تطبیق داشته باشد. $(Z_t = Z_L^*)$ ، بیشترین توان خروجی را خواهیم داشت. در غیر این صورت، با تغییر ظرفیت بانک خازنی از آن نقطه، مقدار P_{out} نیز کاهش پیدا می‌کند.



شکل ۷ جریان فاز C کشیده شده توسط مدار تغذیه کوره؛
الف) در حوزه زمان؛ ب) در حوزه فرکانس

با مقایسه نمودارهای شکل‌های ۸-الف و ۸-ب، تحلیل‌های قبلی در شکل ۳ تأیید می‌شود. همان‌طور که از تغییرات P_{out} و P_{loss} ارائه شده در شکل ۸ مشاهده می‌شود، کاهش خازن از $128\mu F$ به $150\mu F$ باعث افزایش P_{out} و P_{loss} می‌شود اما میزان افزایش P_{out} نسبت به افزایش P_{loss} چشمگیرتر خواهد بود. لذا با این انتخاب بهینه، میزان توان دریافتی توسط کوره در این بازه دمایی افزایش می‌یابد. در نهایت می‌توان گفت که با این انتخاب، تابع ارزش دارای مقدار بیشتری خواهد بود.

همان‌گونه که قبلاً نیز گفته شد، مقدادیر L_{eq} و R_{eq} پارامترهای متغیری هستند که به شرایط بار کوره بستگی دارند. لذا در ادامه شبیه‌سازی، با فرض ثابت بودن L_{eq} و متغیر بودن R_{eq} (مقاومت بار) در محدوده $0,1\Omega$ تا 4Ω ، انتخاب خازن بهینه انجام می‌شود. در این انتخاب از پارامترهای قبلی استفاده شده است.

ثابت بودن C ، افزایش R_{eq} سبب کاهش ضریب کیفیت شدت تشدید و کاهش جریانها از جمله I_C (جریان عبوری از خازن) می‌شود و در نتیجه P_{loss} نیز کاهش می‌یابد.

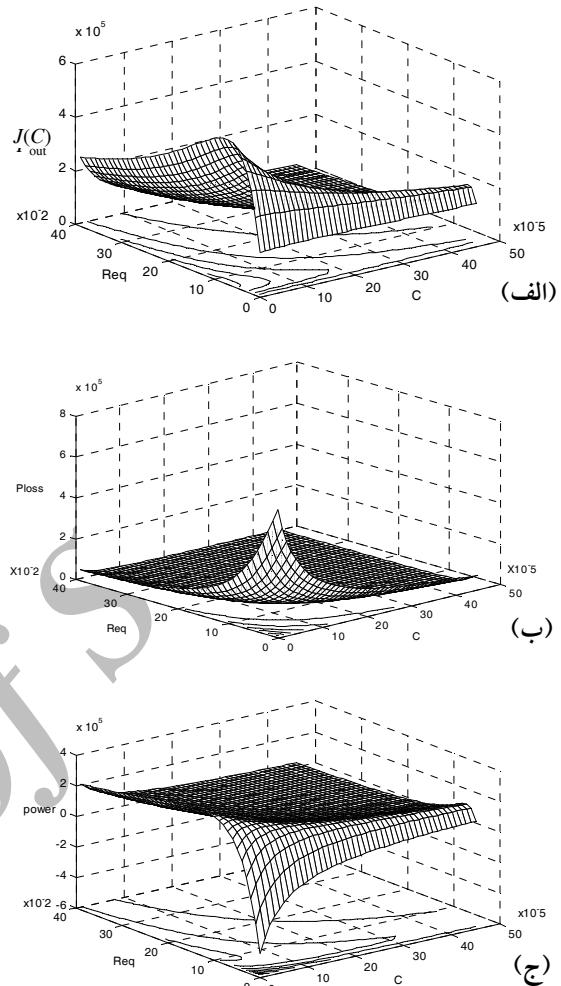
شکل ۹-ج تابع ارزش $J(C)$ را نشان می‌دهد. همانطور که انتظار داریم در یک مقدار نه چندان کوچک C و یک مقدار تطبیق شده برای R_{eq} ، حداقل مقدار تابع ارزش را خواهیم داشت. برای هر کوره، طراحی بهینه خازن برای حالتی که توان به بار نمی‌رسد یا برای زمانی که دما تا حد دلخواه افزایش پیدا نمی‌کند، انجام شده و حالت بهینه برای آن نقطه به دست می‌آید.

۶- نتیجه‌گیری

در این مقاله، مدار معادل مناسبی برای کوره‌های القایی ذوب پیشنهاد شده که در آن، مدل‌سازی کوره و سیستم تغذیه آن به‌شکل دقیقی انجام شده است. سپس برای این مدل روشی برای انتخاب بهینه خازن و فرکانس پیشنهاد شده است. در این راستا حاشیه و لتاژ مناسب برای خازن، حداقل توان خروجی و ضریب قدرت بالا مدنظر است. این انتخاب بهینه، سبب افزایش عمر بانک خازنی و بیشینه شدن توان خروجی می‌شود. در اینجا سعی شده تا مدار کامل تغذیه کوره (از برق شهر تا کوره) به‌شکل دقیقی مدل‌سازی و شبیه‌سازی‌ها بر روی کوره القایی ذوب واقعی انجام شود. نتایج شبیه‌سازی، عملکرد مناسب کوره را با توجه به انتخاب بهینه خازن در حداقل شدن تلفات ارسالی به بار کوره و حداقل شدن تلفات خازن نشان می‌دهد.

۷- تقدیر و تشکر

در پیان مؤلفان سپاس خود را از آقایان دکتر بهزاد میرزاکاریان و مهندس محمد محبی‌زاده به‌خاطر ارائه نظرات



شکل ۹ (الف) تغییرات P_{out} بر اساس تغییرات R_{eq} و C
ب) تغییرات P_{loss} بر اساس تغییرات R_{eq} و C
ج) تغییرات تابع ارزش $J(C)$ بر اساس تغییرات R_{eq} و C

شکل ۹-ب توان تلف شده در خازن P_{loss} را نشان می‌دهد. در کمترین مقدار خازن، اگر چه بیشترین P_{out} را داریم اما به سبب همان افزایش فرکانس، بیشترین تلفات در خازن را نیز داریم. بنابر این خازن کوچک (فرکانس بسیار بالا) مطلوب نیست، زیرا علاوه بر تلفات زیاد بانک خازنی، افزایش فرکانس نیز باعث افزایش اثر پوسته‌ای و کاهش عمق نفوذ می‌شود که اقتصادی نیست. با فرض

- Trans. on Magnetics, Vol. 37, No. 5, 2001, pp. 3719-3723.
- [7] Lee D. Y., Hyun D. S.; "Hybrid Control Scheme of Active-clamped Class E Inverter with Induction Heating Jar for High Power Applications", IEE Proc.-Electr. Power Application, Vol. 151, No. 6, 2004, pp. 704-711.
- [8] Dawson F. P., Jain P.; "A Comparison of Load Commutated Inverter System for Induction Heating and Melting Applications", IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 6, No. 3, 1991, pp. 430-441.
- [9] Power Quality for Induction Melting in Metals Production, Electric Power Research Institute (EPRI), in World Wide Web, <http://www.EPRI.org>, 2002.
- [10] Lee J., Lim S. K., Nam K. H., Choi D.; "An Optimal Selection of Induction Heater Capacitance Considering Dissipation Loss caused by ESR", IEEE APEC 04, Vol. 3, 2004, pp. 1858-1863.
- [11] Bonert R., Lavers J. D.; "Simple Starting Scheme for a Parallel Resonance Inverter for Induction Heating", IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 9 , No. 3, 1994, pp. 281-287.
- [12] Jain P., Espinoza J., Dewan S. h.; "Self Started Voltage Source Series Resonant
- مفید اعلام می‌دارند. همچنین لازم است از شرکت مهندسی خادم و کارخانه مذاب‌ساز که اطلاعات فنی و نقشه‌های کوره را در اختیار قرار دادند قدردانی کنیم.
- ## -۸- منابع
- [۱] فتوحی اردکانی محمدحسین؛ بررسی مبدل‌های DC به AC از نوع کموتاسیون بار؛ انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۷۳.
- [۲] رشید محمد؛ الکترونیک قدرت؛ ترجمه سید ابراهیم افجهای و مجید مهاجر؛ نشر نوپردازان، ۱۳۸۰.
- [۳] Gang L. J., Yan-ru Z., Miao Z.; "Study on a New Method of Voltage-Source Induction Heating Load-Matched", 5th International Conference on Power Electronics and Motion Control, CES/IEEE, Vol. 1, 2006, pp. 1-5.
- [۴] Burdío J. M., Barragán L. A., Monterde F., Navarro D.: "Asymmetrical Voltage-Cancellation Control for Full-Bridge Series Resonant Inverters", IEEE Trans. on Power Electronics; Vol. 19, No. 2, 2004, pp. 461-470.
- [۵] Semiatin S. L., Stutz D. E.; Induction Heat Treatment of Steel, American society for Metals, 1996.
- [۶] Janne N., Jarmo P.; "A Simplified FEM Based Calculation Model for 3-D Induction Heating Problems Using Surface Impedance Formulations", IEEE

- Capacitor Lossless Inductor ZCS Snubber-Assisted Series Load Resonant High Frequency Inverter with Dual Mode Pulse Modulation Scheme”, 5th International Conference on Power Electronics and Motion Control, CES/IEEE, Vol. 2, 2006, pp. 1-5.
- [17] High Frequency Induction Heating, appeared in World Wide, Web: <http://www.Valve advantage. Co. UK, Oct. 2005.>
- [18] Davis J., Simpson P.; Induction Heating HandBook, McGraw Hill Book company (UK), 1979.
- [19] Seguier G., Labrique F.; Power Electronic Converters, Springer-Verlag NewYork, the Forth (DC –AC converter). 1989.
- Converter for High-power Induction Heating and Melting Applications”, IEEE Trans. on Industry Application, Vol. 34, No. 3, 1998, pp. 518-525.
- [13] Lowen S., Michael Z.; “Improving power Factor in the Presence of Harmonics Using Low-Voltage Tuned Filters”, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 29, No. 3, 1993, pp. 528-532.
- [14] Martin R.; Harmonic distortion and Analysis, IEC 555-2, Compliance Engineering, Fall 1991.
- [15] Khan I., Naylor E., Tapson, J.; “Optimised Control for High Frequency Induction Heating Power Sources”, International Conference on Power Electronics and Drives Systems, PEDS, Vol. 2, 2005, pp. 1015-1018.
- [16] Fathy K., Okude T., Omori H., Hyun Woo Lee, Nakaoka M.; “A Switched-

Archive of SID